

## Patente

- IBM Technical Disclosure Bulletin Vol. 34. No. 5 October 1991 für "Hole Pattern Writing and Lift-off Technique using STM"
- Nahfeldoptische Spitze, Deutsches Patent Nr. 195 04 662.5-42
- Herstellungsverfahren für poröses Silizium und elektronisches Bauelement mit porösem Silizium, AZ10047664.3, eingereicht 26. 9. 2000, veröffentlicht 28.3.2001
- Verfahren zu organischen templatunterstützten Strukturierung und Wachstum im Nanometerbereich Deutsches Patent, angemeldet, Prüfantrag 2005